

DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

015727388

WPI Acc No: 2003-789588/200375

XRPX Acc No: N03-632455

Plasma processing apparatus for semiconductor wafer in manufacture of electronic devices, moves plasma generator with respect to wafer while processing

Patent Assignee: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (MATU); MATSUSHITA DENKI SANGYO KK (MATU); KIMURA T (KIMU-I); OKUMURA T (OKUM-I); SAITOH M (SAIT-I); SATO K (SATO-I); YASHIRO Y (YASH-I)

Inventor: KIMURA T; OKUMURA T; SAITOH M; SATO K; YASHIRO Y

Number of Countries: 004 Number of Patents: 005

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
CN 1438831	A	20030827	CN 2003104127	A	20030214	200375 B
JP 2003347284	A	20031205	JP 200333393	A	20030212	200422
JP 2003309112	A	20031031	JP 2002309349	A	20021024	200379
KR 2003069092	A	20030825	KR 20039450	A	20030214	200405
US 20040075396	A1	20040422	US 2003365449	A	20030213	200428

Priority Applications (No Type Date): JP 2002309349 A 20021024; JP 200238103 A 20020215; JP 200276816 A 20020319

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
CN 1438831	A			H05H-001/42	
JP 2003347284	A		9	H01L-021/3065	
JP 2003309112	A		16	H01L-021/3065	
KR 2003069092	A			H01L-021/3065	
US 20040075396	A1			G09G-003/10	

Abstract (Basic): JP 2003347284 A

<PatAbs><SelDwgs>1</SelDwgs><TotalDwgs
Total='8'><PatAbsBody><PNov><P>A control unit maintains the pressure in the discharge space formed between electrodes (1,2) of plasma generator as 100Pa-200KPa, and the product (PD) of the pressure and the width of the discharge space as 0.1-120Pam. A transfer assembly (10) moves the plasma generator with respect to the wafer (8) while processing. </P></PNov><PDesc><P>An INDEPENDENT CLAIM is also included for plasma processing method. </P></PDesc><Puse><P>Plasma processing apparatus for semiconductor wafer in manufacture of electronic devices, micromachine. </P></Puse><Padv><P>Performs plasma processing by regulating the pressure of the discharge space between the electrodes efficiently, without generating strong electromagnetic waves and without using mask pattern. </P></Padv><PDDWG><PSimplePara>The figure shows the outline block diagram of the plasma processing apparatus. (Drawing includes non-English language text).

</PSimplePara><PSimplePara><Part><PartName>
electrodes</PartName><PartNo>1, 2</PartNo></Part></PSimplePara><PSimpleP
ara><Part><PartName> high-frequency electric power
unit</PartName><PartNo>3</PartNo></Part></PSimplePara><PSimplePara><Par
t><PartName> gas supply
apparatus</PartName><PartNo>6</PartNo></Part></PSimplePara><PSimplePara
><Part><PartName>
wafer</PartName><PartNo>8</PartNo></Part></PSimplePara><PSimplePara><Pa
rt><PartName> transfer
assembly</PartName><PartNo>10</PartNo></Part></PSimplePara><PSimplePara
><Part><PartName> discharge
space</PartName><PartNo>S</PartNo></Part></PSimplePara></PDDWG><POnline
><POnov><OP> </OP></POnov></POnline></PatAbsBody></PatAbs>

Title Terms: PLASMA; PROCESS; APPARATUS; SEMICONDUCTOR; WAFER; MANUFACTURE;
ELECTRONIC; DEVICE; MOVE; PLASMA; GENERATOR; RESPECT; WAFER; PROCESS

Derwent Class: P84; P85; X14; X24

International Patent Class (Main): G09G-003/10; H01L-021/3065; H05H-001/42

International Patent Class (Additional): B01J-019/08; C23C-016/505;

C23F-004/00; G03F-007/36; H01L-021/31; H05H-001/24

File Segment: EPI; EngPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

07852637 **Image available**

PLASMA TREATMENT APPARATUS AND METHOD

PUB. NO.: 2003-347284 [JP 2003347284 A]

PUBLISHED: December 05, 2003 (20031205)

INVENTOR(s): YASHIRO YOICHIRO

 OKUMURA TOMOHIRO

 KIMURA TADASHI

 SAITO MITSUHISA

APPLICANT(s): MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

APPL. NO.: 2003-033393 [JP 200333393]

FILED: February 12, 2003 (20030212)

PRIORITY: 2002-076816 [JP 200276816], JP (Japan), March 19, 2002
 (20020319)

INTL CLASS: H01L-021/3065; B01J-019/08; C23C-016/505; H01L-021/31;
 H05H-001/24

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a plasma treatment apparatus and a method which can form a pattern by treating an extremely small area at a low cost without using a mask pattern.

SOLUTION: The plasma treatment of an arbitrary pattern is performed without using a mask pattern by disposing a 1st electrode 1 and a 2nd electrode 2 opposite each other to form a discharge space between both the electrodes, forming plasma in the discharge space S by applying high frequency electric power to the 1st electrode by a high frequency power source 3 while supplying gas to the discharge space S by a gas supply means 6, and relatively moving an object to be treated such as a substrate 8 by a moving device 10 opposite closely to the opening 7 of the discharge space S.

COPYRIGHT: (C) 2004, JPO

?

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-347284

(P 2 0 0 3 - 3 4 7 2 8 4 A)

(43) 公開日 平成15年12月5日 (2003.12.5)

(51) Int. Cl. ⁷

識別記号

F I

テ-マコード (参考)

H01L 21/3065

B01J 19/08

C23C 16/505

H01L 21/31

H05H 1/24

B01J 19/08

C23C 16/505

H01L 21/31

H05H 1/24

H01L 21/302

101

E 4G075

4K030

C 5F004

5F045

E

審査請求 未請求 請求項の数32 O L (全9頁)

(21) 出願番号

特願2003-33393 (P 2003 - 33393)

(22) 出願日

平成15年2月12日 (2003.2.12)

(31) 優先権主張番号

特願2002-76816 (P 2002 - 76816)

(32) 優先日

平成14年3月19日 (2002.3.19)

(33) 優先権主張国

日本 (J P)

(71) 出願人

000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者

矢代 陽一郎

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72) 発明者

奥村 智洋

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74) 代理人

100080827

弁理士 石原 勝

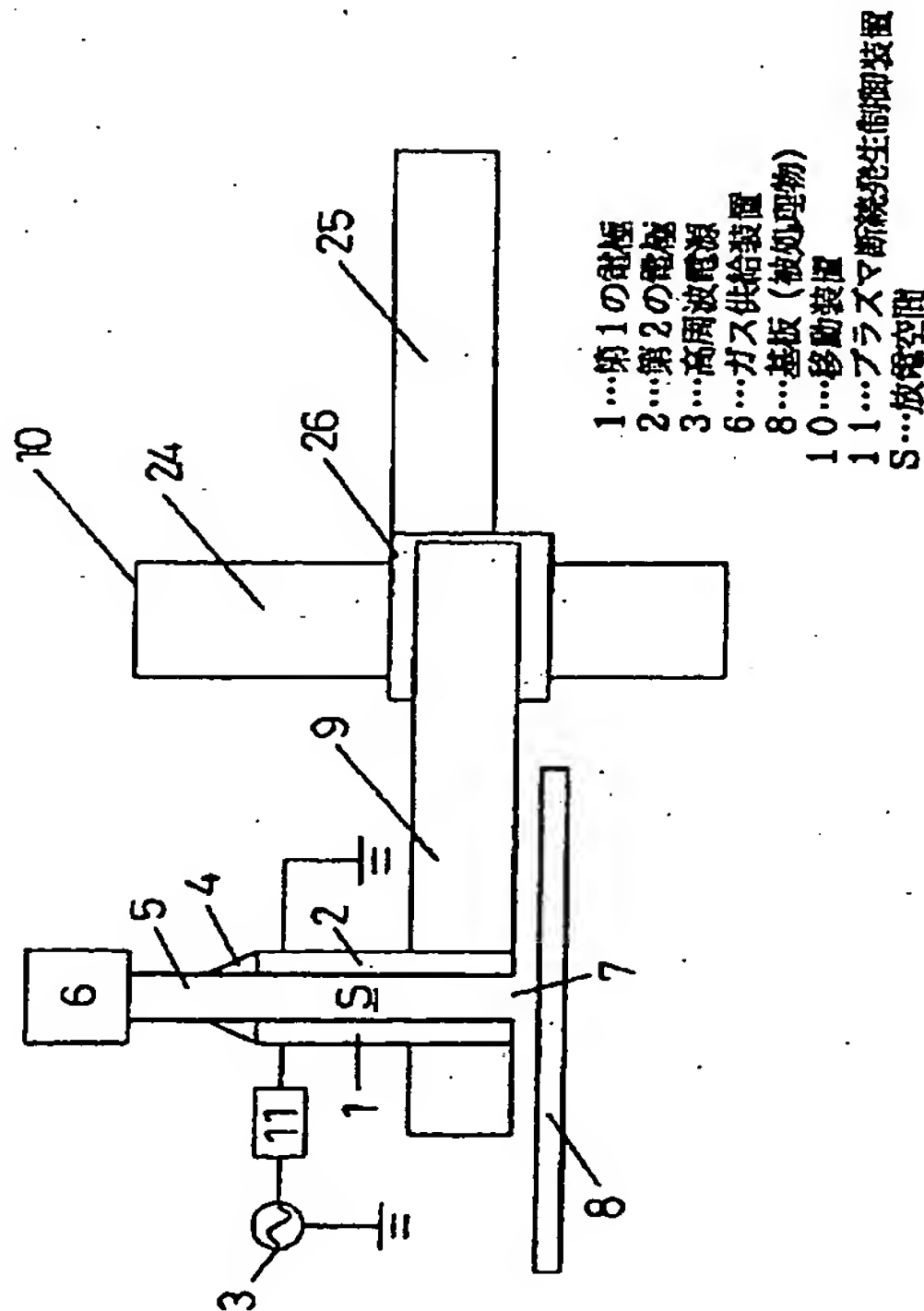
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 プラズマ処理装置及び方法

(57) 【要約】

【課題】 マスクパターンを用いずに、低コストで微小領域を処理し、パターンを形成することができるプラズマ処理装置及び方法を提供する。

【解決手段】 第1の電極1と第2の電極2を対向配置して両電極の間に放電空間Sを形成し、放電空間Sにガス供給手段6にてガスを供給しつつ第1の電極1に高周波電源3にて高周波電力を印加することで放電空間Sにプラズマを発生させ、放電空間Sの開口部7に近接して基板8などの被処理物を臨ませて移動装置10にて相対移動させることにより、マスクパターンを用いずに任意のパターンのプラズマ処理を行うようにした。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 高周波電源と、高周波電源に接続された第 1 の電極と第 1 の電極に対向する第 2 の電極と第 1 と第 2 の電極間のプラズマ放電を生成するための放電空間とを備えたプラズマ発生部と、放電空間にガスを供給するガス供給装置と、放電空間の圧力が $100\text{ Pa} \sim 200\text{ kPa}$ でかつ放電空間の圧力 P と放電空間の厚み D との積 PD を $0.1 \sim 120 (\text{Pa} \cdot \text{m})$ となるように制御する制御装置と、プラズマ発生部と被処理物を相対移動させる移動装置とを備えたことを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項 2】 プラズマ発生部を被処理物に対して動かす移動装置を備えたことを特徴とする請求項 1 記載のプラズマ処理装置。

【請求項 3】 被処理物をプラズマ発生部に対して動かす移動装置を備えたことを特徴とする請求項 1 記載のプラズマ処理装置。

【請求項 4】 放電空間の一端にガス供給装置を接続し、放電空間の他端の開口部に対向して被処理物を配置したことを特徴とする請求項 1 記載のプラズマ処理装置。

【請求項 5】 プラズマを断続的に発生させるプラズマ断続発生制御装置を設けたことを特徴とする請求項 1 記載のプラズマ処理装置。

【請求項 6】 移動装置が、フィルム状の被処理物を巻き取るロールを有することを特徴とする請求項 1 記載のプラズマ処理装置。

【請求項 7】 高周波電源は、周波数が $1\text{ MHz} \sim 5\text{ GHz}$ の高周波電力を出力するものであることを特徴とする請求項 1 記載のプラズマ処理装置。

【請求項 8】 第 1 と第 2 の電極を対向配置して両電極の間に放電空間を形成し、放電空間にガスを供給し、放電空間の圧力を $100\text{ Pa} \sim 200\text{ kPa}$ に保つとともに放電空間の圧力 P と放電空間の厚み D の積 PD が $0.1 \sim 120 (\text{Pa} \cdot \text{m})$ となるように制御し、第 1 の電極に高周波電力を印加することで放電空間にプラズマを発生させ、発生させたプラズマと被処理物を相対的に動かし、発生させたプラズマにて被処理物を処理することを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項 9】 ガスとして反応性を持つものを用いることを特徴とする請求項 8 記載のプラズマ処理方法。

【請求項 10】 ガスとして、少なくともハロゲン元素、酸素、窒素の何れか 1 つを含むものを用いることを特徴とする請求項 9 記載のプラズマ処理方法。

【請求項 11】 ガスとして、希ガスを用いることを特徴とする請求項 8 記載のプラズマ処理方法。

【請求項 12】 高周波電力の周波数として、 $1\text{ MHz} \sim 5\text{ GHz}$ を用いることを特徴とする請求項 8 記載のプラズマ処理方法。

【請求項 13】 プラズマを断続的に発生させながら処

理することを特徴とする請求項 8 ～ 12 の何れかに記載のプラズマ処理方法。

【請求項 14】 ワークをロール状に巻き取りながら処理することを特徴とする請求項 8 記載のプラズマ処理方法。

【請求項 15】 電極と、電極または被処理物に高周波電力を供給する高周波電源と、電極と被処理物間にプラズマ放電を生成するための放電空間とを備えたプラズマ発生部と、放電空間にガスを供給するガス供給装置と、放電空間の圧力が $100\text{ Pa} \sim 200\text{ kPa}$ でかつ放電空間の圧力 P と放電空間の厚み D との積 PD を $0.1 \sim 120 (\text{Pa} \cdot \text{m})$ となるように制御する制御装置と、プラズマ発生部と被処理物を相対移動させる移動装置とを備えたことを特徴とするプラズマ処理装置。

【請求項 16】 プラズマ発生部を被処理物に対して動かす移動装置を備えたことを特徴とする請求項 15 記載のプラズマ処理装置。

【請求項 17】 被処理物をプラズマ発生部に対して動かす移動装置を備えたことを特徴とする請求項 15 記載のプラズマ処理装置。

【請求項 18】 電極の内部に設けたガス供給通路の一端にガス供給装置を接続し、ガス供給通路の他端の開口部に対向して被処理物を配置したことを特徴とする請求項 15 記載のプラズマ処理装置。

【請求項 19】 プラズマを断続的に発生させるプラズマ断続発生制御装置を設けたことを特徴とする請求項 15 記載のプラズマ処理装置。

【請求項 20】 移動装置が、フィルム状の被処理物を巻き取るロールを有することを特徴とする請求項 15 記載のプラズマ処理装置。

【請求項 21】 高周波電源は、周波数が $1\text{ MHz} \sim 5\text{ GHz}$ の高周波電力を出力するものであることを特徴とする請求項 15 記載のプラズマ処理装置。

【請求項 22】 被処理物は高周波電源が接続され、電極は接地されていることを特徴とする請求項 15 記載のプラズマ処理装置。

【請求項 23】 電極は高周波電源が接続され、被処理物は接地されていることを特徴とする請求項 15 記載のプラズマ処理装置。

【請求項 24】 電極と被処理物を対向配置し放電空間を形成し、放電空間にガスを供給し、放電空間の圧力を $100\text{ Pa} \sim 200\text{ kPa}$ に保つとともに放電空間の圧力 P と放電空間の厚み D の積 PD が $0.1 \sim 120 (\text{Pa} \cdot \text{m})$ となるように制御し、高周波電力を印加することで放電空間にプラズマを発生させ、発生させたプラズマと被処理物を相対的に動かし、発生させたプラズマにて被処理物を処理することを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項 25】 ガスとして反応性を持つものを用いることを特徴とする請求項 24 記載のプラズマ処理方法。

【請求項 26】 ガスとして、少なくともハロゲン元素、酸素、窒素の何れか 1 つを含むものを用いることを特徴とする請求項 25 記載のプラズマ処理方法。

【請求項 27】 ガスとして、希ガスを用いることを特徴とする請求項 24 記載のプラズマ処理方法。

【請求項 28】 高周波電力の周波数として、1MHz～5GHz を用いることを特徴とする請求項 24 記載のプラズマ処理方法。

【請求項 29】 プラズマを断続的に発生させながら処理することを特徴とする請求項 24 記載のプラズマ処理方法。

【請求項 30】 ワークをロール状に巻き取りながら処理することを特徴とする請求項 24 記載のプラズマ処理方法。

【請求項 31】 被処理物に高周波電力を印加し、電極は接地することを特徴とする請求項 24 記載のプラズマ処理方法。

【請求項 32】 電極に高周波力を印加し、被処理物は接地することを特徴とする請求項 24 記載のプラズマ処理方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、半導体等の電子デバイスやマイクロマシンの製造工程に適用するプラズマ処理方法及び装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来のプラズマ処理装置として、例えば特開 2000-164395 号公報や特開平 9-27482 号公報に開示されたものが知られている。

【0003】 特開 2000-164395 号公報に開示された基板電極プラズマ発生装置を図 7 を参照して説明すると、表面を酸化したシリコン基板 105 上にタングステンをスパッタ蒸着した後、ドライエッチングすることによって形成された微小ギャップ薄膜電極対 101、102、103、104 のアレイにて構成されている。シリコン基板 105 上に配置された微小ギャップ薄膜電極対 101、102、103、104 に高周波電力を供給することで、微小ギャップ薄膜電極対にプラズマを発生させ、エッチング、堆積、表面改質等のプラズマ処理を行う。

【0004】 特開平 9-27482 号公報に開示されたマイクロ波を用いたプラズマエッチング装置を図 8 を参照して説明すると、マグネトロン 111 で発生した 2.45GHz のマイクロ波を導波管 112 を通して反応性ガス供給管 113 を通る CF₄ と酸素の混合ガスに印加し、反応性ガスをプラズマ化する。プラズマ化した反応性ガスは、ノズル 114 からウエハ 115 の凸部 115a に当てられてエッチングされる。エッチング中に発生した反応生成物は、反応性ガス供給管 113 の外周に同軸状に配設された反応生成物排気管 116 の吸引口から

吸引されて外部に排気される。

【0005】 また、ウエハ 115 の表面を局部的にエッチングするために、ウエハ 115 を移動台 117 に吸着固定して、駆動手段 118 にて移動台 117 を X、Y、θ 方向に移動させるように構成されている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記した従来方式では、低コストで微小領域を処理し、パターンを形成するようなプラズマ処理が困難であるという問題がある。

【0007】 図 7 の基板電極プラズマ発生装置においては、シリコン基板 105 上に設けられた微小ギャップ薄膜電極対 101～104 のアレイに近接した領域のみプラズマ処理可能であるため、所望のパターンを形成するためには、そのパターンに対応して微小ギャップ薄膜電極対を作成する必要がある、マスクパターンを用いる代わりに微小ギャップ薄膜電極対をパターンニングする必要があり、その分コストがかかるという問題がある。

【0008】 図 8 のプラズマエッチング装置においては、発生したプラズマ中に存在する粒子のうち、ラジカルだけがプラズマから離れたノズル 114 外に拡散するため、この種の装置では主としてラジカルによって処理を行うことになる。主にラジカルのみを用いた処理は、被処理物全面にわたる処理には適用できるが、被処理物上の一部のみの処理には適用できない。これはガス同様ラジカルが等方的に拡散すると考えられるからである。従って、この種の装置を、微小領域を処理しパターン形成するようなプロセスに適用するためには、マスクパターンを用いなければならず、低コストで微小領域を処理し、パターン形成するようなプロセスが困難であるという問題がある。

【0009】 本発明は、上記従来の問題点に鑑み、マスクパターンを用いずに、低コストで微小領域を処理し、パターンを形成することができるプラズマ処理装置及び方法を提供することを目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】 第 1 発明のプラズマ処理装置は、高周波電源と、高周波電源に接続された第 1 の電極と第 1 の電極に対向する第 2 の電極と第 1 と第 2 の電極間のプラズマ放電を生成するための放電空間とを備えたプラズマ発生部と、放電空間にガスを供給するガス供給装置と、放電空間の圧力が 100Pa～200kPa でかつ放電空間の圧力 P と放電空間の厚み D との積 P・D を 0.1～120 (Pa・m) となるように制御する制御装置と、プラズマ発生部と被処理物を相対移動させる移動装置とを備えたものであり、電極間の放電空間にガスを供給して発生させたプラズマにて放電空間に臨む微小領域を処理でき、そのプラズマ発生部と被処理物の相対移動によってマスクパターンを用いずに任意のパターンを処理することができ、また放電空間の圧力、及び

放電空間の圧力と厚みの関係を上記のように規制することで、高価な真空排気手段を用いずに安価にかつ強い電磁波を発生することなくプラズマ処理でき、また印加電圧を極端に高くすることなく、放電着火してプラズマ処理を開始することができる。

【0011】また、プラズマ発生部を被処理物に対して動かす移動装置、若しくは被処理物をプラズマ発生部に対して動かす移動装置を備えるのが好適である。

【0012】また、放電空間の一端にガス供給装置を接続し、放電空間の他端の開口部に対向して被処理物を配置すると、微小領域の処理に好適である。

【0013】また、プラズマを断続的に発生させるプラズマ断続発生制御装置を設けると、断続的なパターンを容易に形成できる。

【0014】また、移動装置が、フィルム状の被処理物を巻き取るロールを有すると、フィルム状の被処理物を処理するのに好適である。

【0015】また、高周波電源が、周波数が1MHz～5GHzの高周波電力を出力するものであると、電極の消耗を抑制できかつプラズマ放電が安定して好適である。

【0016】第2発明のプラズマ処理方法は、第1と第2の電極を対向配置して両電極の間に放電空間を形成し、放電空間にガスを供給し、放電空間の圧力を100Pa～200kPaに保つとともに放電空間の圧力Pと放電空間の厚みDの積PDが0.1～120(Pa・m)となるように制御し、第1の電極に高周波電力を印加することで放電空間にプラズマを発生させ、発生させたプラズマと被処理物を相対的に動かし、発生させたプラズマにて被処理物を処理するものであり、電極間の放電空間にガスを供給して発生させたプラズマにて放電空間に臨む微小領域を処理しつつ動かすことで任意のパターンをマスクパターンを用いずに処理することができ、また放電空間の圧力、及び放電空間の圧力と厚みの関係を上記のように規制することで、高価な真空排気手段を用いずに安価にかつ強い電磁波を発生することなくプラズマ処理でき、また印加電圧を極端に高くすることなく、放電着火してプラズマ処理を開始することができる。

【0017】また、ガスとしては、処理に応じて反応性を持つもの、特に少なくともハロゲン元素、酸素、窒素の何れか1つを含むものを用いることができ、また希ガスをを用いるとプラズマ放電を開始させやすい。

【0018】また、高周波電力の周波数として、1MHz～5GHzを用いると、電極の消耗を抑制できかつプラズマ放電が安定して好適である。

【0019】また、プラズマを断続的に発生させながら処理すると、任意に断続的なパターンを形成することができる。

【0020】また、被処理物をロール状に巻き取りなが

ら処理すると、フィルム状の被処理物を処理するのに好適である。

【0021】第3発明のプラズマ処理装置は、電極と、電極または被処理物に高周波電力を供給する高周波電源と、電極と被処理物間にプラズマ放電を生成するための放電空間とを備えたプラズマ発生部と、放電空間にガスを供給するガス供給装置と、放電空間の圧力が100Pa～200kPaでかつ放電空間の圧力Pと放電空間の厚みDとの積PDを0.1～120(Pa・m)となるように制御する制御装置と、プラズマ発生部と被処理物を相対移動させる移動装置とを備えたものであり、電極と被処理物間の放電空間にガスを供給して発生させたプラズマにて放電空間に臨む微小領域を処理しつつ動かすことで任意のパターンをマスクパターンを用いずに処理することができ、また放電空間の圧力、及び放電空間の圧力と厚みの関係を上記のように規制することで、高価な真空排気手段を用いずに安価にかつ強い電磁波を発生することなくプラズマ処理でき、また印加電圧を極端に高くすることなく、放電着火してプラズマ処理を開始することができる。

【0022】また、プラズマ発生部を被処理物に対して動かす移動装置、若しくは被処理物をプラズマ発生部に対して動かす移動装置を備えるのが好適である。

【0023】また、電極の内部に設けたガス供給通路の一端にガス供給装置を接続し、ガス供給通路の他端の開口部に対向して被処理物を配置すると、微小領域の処理に好適である。

【0024】また、プラズマを断続的に発生させるプラズマ断続発生制御装置を設けると、断続的なパターンを容易に形成できる。

【0025】また、移動装置が、フィルム状の被処理物を巻き取るロールを有すると、フィルム状の被処理物を処理するのに好適である。

【0026】また、高周波電源が、周波数が1MHz～5GHzの高周波電力を出力するものであると、電極の消耗を抑制できかつプラズマ放電が安定して好適である。

【0027】また、被処理物に高周波電源を接続し、電極を接地する、または、電極に高周波電源を接続し、被処理物を接地すると、より高い処理速度が得られ好適である。

【0028】第4発明のプラズマ処理方法は、電極と被処理物を対向配置し放電空間を形成し、放電空間にガスを供給し、放電空間の圧力を100Pa～200kPaに保つとともに放電空間の圧力Pと放電空間の厚みDの積PDが0.1～120(Pa・m)となるように制御し、高周波電力を印加することで放電空間にプラズマを発生させ、発生させたプラズマと被処理物を相対的に動かし、発生させたプラズマにて被処理物を処理するものであり、電極間の放電空間にガスを供給して発生させた

適当な高周波電源 7 の周波数は 1 MHz ～ 5 GHz である。

【0042】（第 2 の実施形態）次に、本発明の第 2 の実施形態について、図 4 を参照して説明する。なお、上記第 1 の実施形態と同一の構成要素については、同一の参照符号を付して説明を省略し、主として相違点のみを説明する。

【0043】図 4 において、第 1 と第 2 の電極 1、2 及びステージ 9 と移動装置 10 が、圧力を減圧または高圧に保持できる耐圧容器 12 の中に配置され、耐圧容器 12 はガス配管 5 を介してガス供給装置 6 に接続され、さらに耐圧容器 12 はガス配管 13 及び圧力制御装置 14 を介して真空ポンプ 15 と接続されている。このため、耐圧容器 12 内の全体、特に第 1 と第 2 の電極 1、2 間の放電空間 S は任意のガスを流通させることができ、また任意の圧力に制御することが可能である。従って、ガス種及び圧力を変化させて処理を行うことができる。

【0044】

【表 1】

圧力 (kPa)	エッチングレート (nm/min)
1	300
10	1000
100	2000

【0045】表 1 は、図 4 の装置構成において、電極 1、2 間の間隔を 1 mm とし、ガスとして酸素を用い、有機膜をエッチングした際のエッチングレートの圧力依存性を示したものである。圧力の上昇とともにエッチングレートの上昇がみられ、圧力の制御によるエッチングレートの制御が可能であることが分かる。

【0046】また、本実施形態において、プラズマ処理に用いる圧力としては、大気圧の約 2 倍である 200 kPa 以上の場合には比較的強い電磁波を発生することがあるため、本実施形態の装置構成においては 200 kPa 以下で処理を行う必要がある。また、100 Pa 以下の場合においては、真空ポンプ 15 として高価なターボ分子ポンプなどをさらに備える必要があり、結果として高コストとなるため適当でない。従って、圧力 P は 100 Pa 以上、200 kPa 以下で処理するのが望ましい。

【0047】さらに、以上に述べた本実施形態においては、プラズマ処理に用いるガスとして酸素を用いた場合についてのみ述べたが、反応性ガス、特にハロゲン元素、酸素、窒素などを含むガス、またはプラズマ放電を開始させやすい希ガスなどであれば容易に処理を行うことができる。

【0048】（第 3 の実施形態）次に、本発明の第 3 の実施形態について、図 5 を参照して説明する。なお、上記第 1 の実施形態と同一の構成要素については、同一の参照符号を付して説明を省略し、主として相違点のみを

説明する。

【0049】図 5 において、第 1 と第 2 の電極 1、2 間の放電空間 S の開口部 7 に近接させて、被処理物として基板 8 に代えてフィルム 18 を配置し、このフィルム 18 に対してエッチング、成膜、表面改質等の各種プラズマ処理を行うように構成されている。

【0050】フィルム 18 は、処理前のフィルム 18 を巻回した処理前ロール 16 から引き出して供給され、処理後のフィルム 18 を処理後ロール 17 にて巻き取るように構成されている。

【0051】以上の各実施形態においては、第 1 と第 2 の電極 1、2 間の放電空間 S を形成したプラズマ発生部をステージ 9 と 3 次元移動可能な移動装置 10 にて移動させるように構成したものを例示したが、移動装置 10 は 3 次的に位置制御可能な駆動機構であれば良く、図 2 で説明した機構に限らず、ダイヤルゲージを用いる方式や圧電素子を用いた駆動機構など、制御の精度や用途に適したものをを用いることができる。また、プラズマ発生部と被処理物の位置を相対的に代えれば良いので、上述した機構と同様のものを被処理物側に配設してもよいことは言うまでもない。

【0052】（第 4 の実施形態）次に、本発明の第 4 実施形態について、図 6 を参照して説明する。図 6 において、被処理物 33 と電極 34 をそれぞれ対向して配置し、電極 34 の内部に放電空間を構成するガス供給流路 35 を設け、その一端のガス供給口 4 をガス配管 5 を用いてガス供給装置 6 と接続し、ガスを電極 34 と被処理物 33 との間にガス供給流路 35 を通して流通させ、ガス供給流路 35 を含む電極 34 と被処理物 33 との間にプラズマ放電を生成するための放電空間を形成している。そして、被処理物 33 に高周波電源 3 を接続して高周波電力を印加し、電極 34 を接地することで、被処理物 33 と電極 34 との間の放電空間にプラズマ放電を発生することができ、かつ電極 34 の内部に設けたガス供給流路 35 のガス供給口 4 と反対側の開口部 7 に近接させて被処理物 33 を配置することで、被処理物 33 に対してエッチング、成膜、表面改質等の各種プラズマ処理を行うことができる。さらに、図 6 において電極 34 はステージ 9 に固定され、ステージ 9 は 3 次的に位置制御可能な移動装置 10 に接続されているため、プラズマ処理を実施しながらステージを動かすことにより、特定の領域にわたり任意のプラズマ密度でプラズマ処理をおこなうことができる。

【0053】以上述べた第 4 実施形態においては、プラズマ発生部における高周波電源の印加形式のみが、第 1 ～ 第 3 実施形態と異なっているが、形成される放電空間と被処理物との位置関係は等価であり、上記第 1 ～ 第 3 実施形態においてみられた効果は本第 4 実施形態に適用しても同様に得られることはいうまでもない。

【0054】また、被処理物に高周波電力を供給する方

式であるため、被処理物に到達するイオンのエネルギーを高めることができるので、より高い速度で異方性に優れたエッチング加工が行えるという利点がある。

【0055】

【発明の効果】本発明のプラズマ処理装置及び方法によれば、以上のように第1と第2の電極を対向配置して両電極の間に放電空間を形成し、放電空間にガスを供給し、放電空間の圧力を100Pa～200kPaに保つとともに放電空間の圧力Pと放電空間の厚みDの積PDが0.1～120(Pa・m)となるように制御し、第1の電極に高周波電力を印加することで放電空間にプラズマを発生させ、発生させたプラズマと被処理物を相対的に動かし、発生させたプラズマにて被処理物を処理するようにしたので、電極間の放電空間にガスを供給して発生させたプラズマにて放電空間に臨む微小領域を処理しつつ動かすことで任意のパターンをマスクパターンを用いずに処理することができ、また放電空間の圧力、及び放電空間の圧力と厚みの関係を上記のように規制することで、高価な真空排気手段を用いずに安価にかつ強い電磁波を発生することなくプラズマ処理でき、また印加電圧を極端に高くすることなく、放電着火してプラズマ処理を開始することができる。

【0056】また、放電空間の一端からガスを供給し、放電空間の他端の開口部に対向して配置した被処理物を処理するようにすると、微小領域の処理に好適である。

【0057】また、プラズマを断続的に発生させながら処理すると、任意に断続的なパターンを形成することができる。

【0058】また、被処理物の移動装置が、フィルム状の被処理物を巻き取るロールであると、フィルム状の被処理物を処理するのに好適である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のプラズマ処理装置の第1の実施形態の概略構成図。

【図2】同実施形態における移動手段の概略構成図。

【図3】同実施形態における処理工程の説明図。

【図4】本発明のプラズマ処理装置の第2の実施形態の概略構成図。

【図5】本発明のプラズマ処理装置の第3の実施形態の概略構成図。

【図6】本発明のプラズマ処理装置の第4の実施形態の概略構成図。

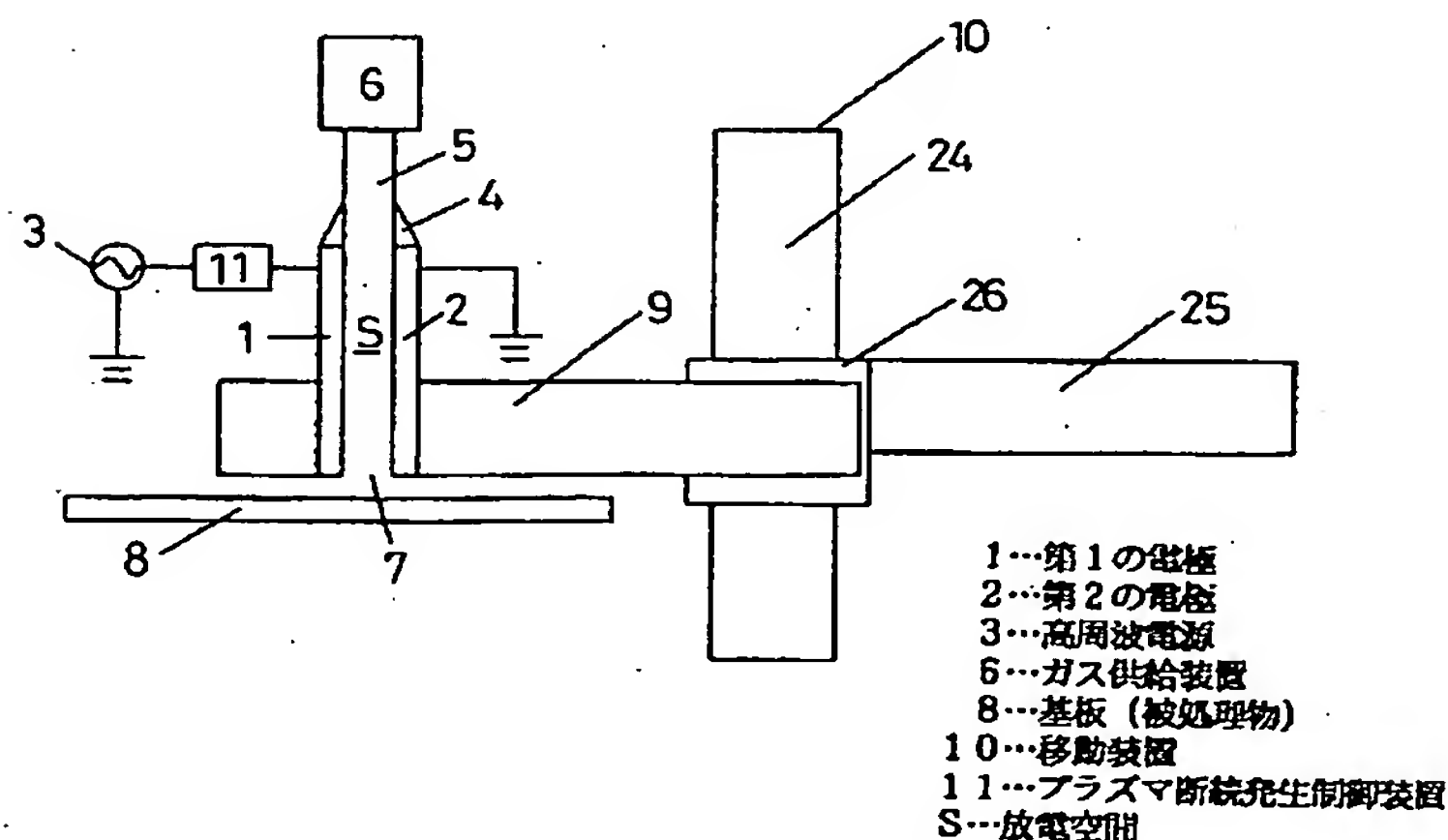
【図7】第1の従来例のプラズマ処理装置の構成を示す斜視図。

【図8】第2の従来例のプラズマ処理装置の構成を示す断面図。

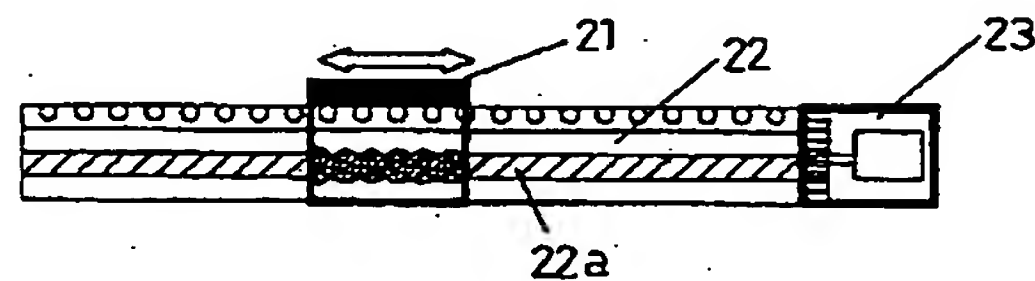
【符号の説明】

- 1 第1の電極
- 2 第2の電極
- 3 高周波電源
- 6 ガス供給装置
- 8 基板(被処理物)
- 10 移動装置
- 11 プラズマ断続発生制御装置
- 16 処理前ロール
- 17 処理後ロール
- 18 フィルム(被処理物)
- 31 プラズマ
- 33 被処理物
- 34 電極
- 35 ガス供給流路
- S 放電空間

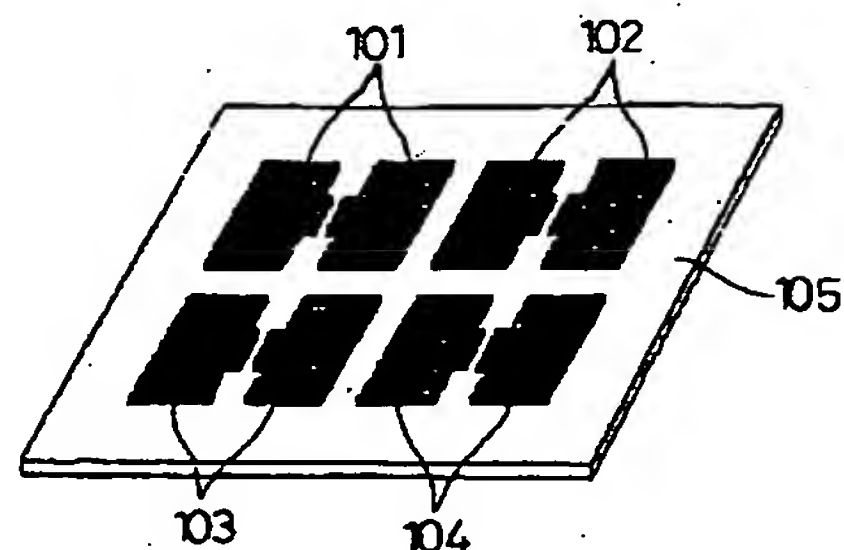
【図1】



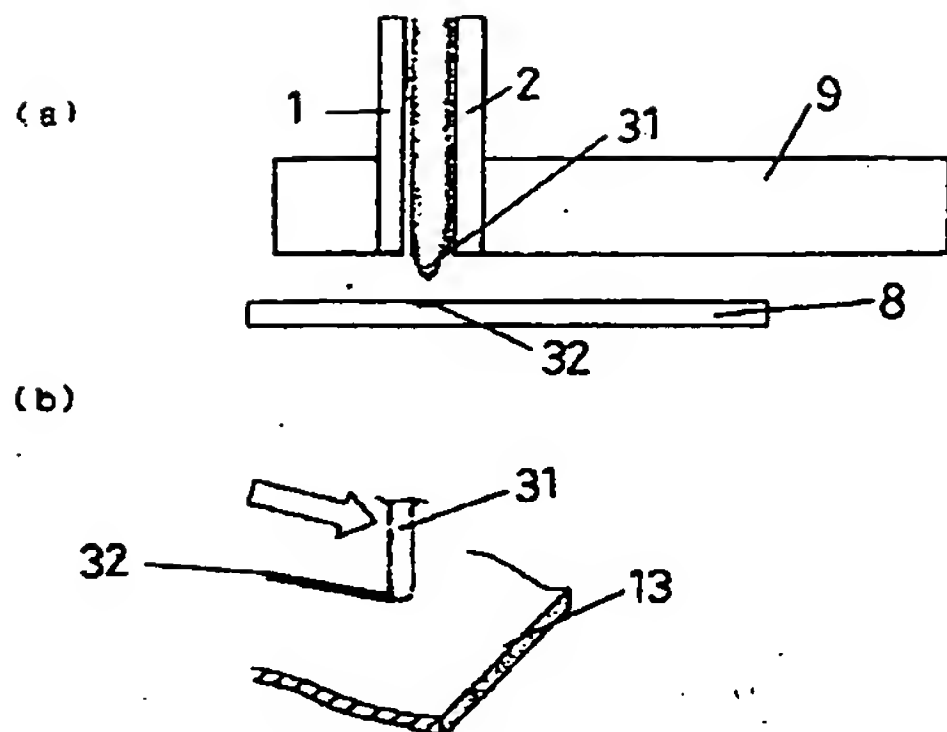
【図2】



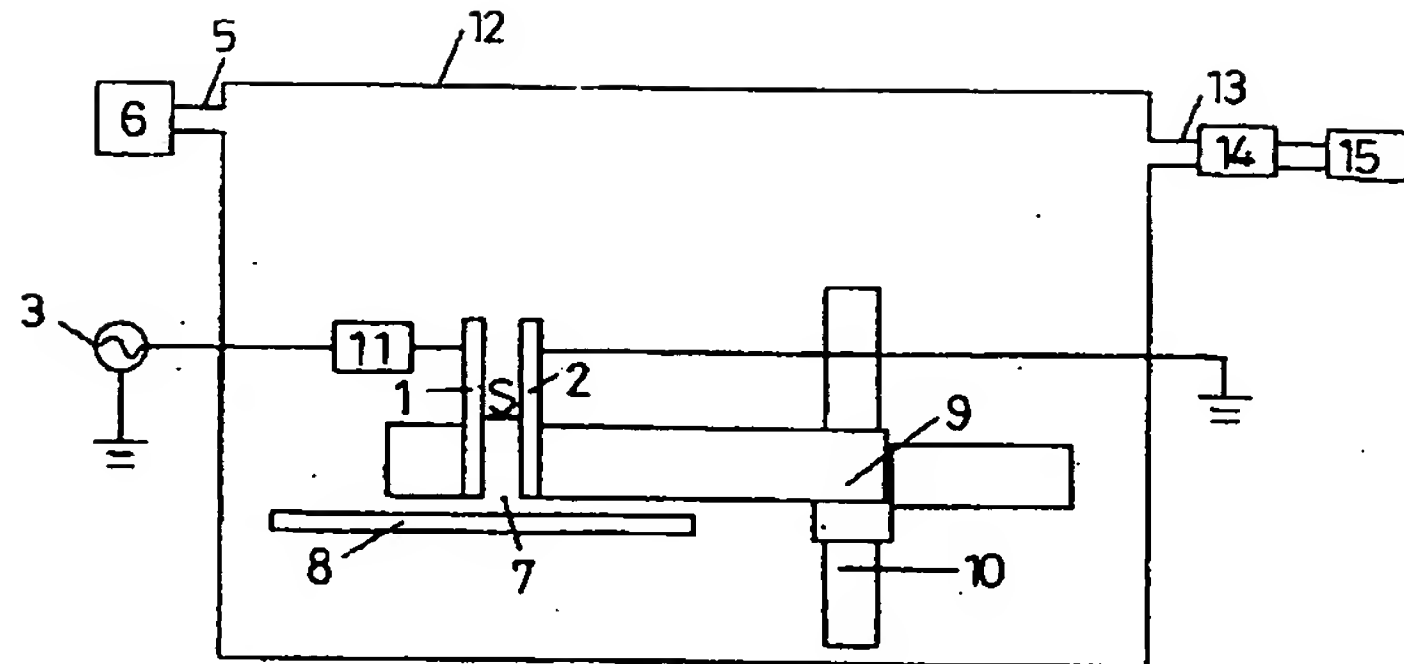
【図7】



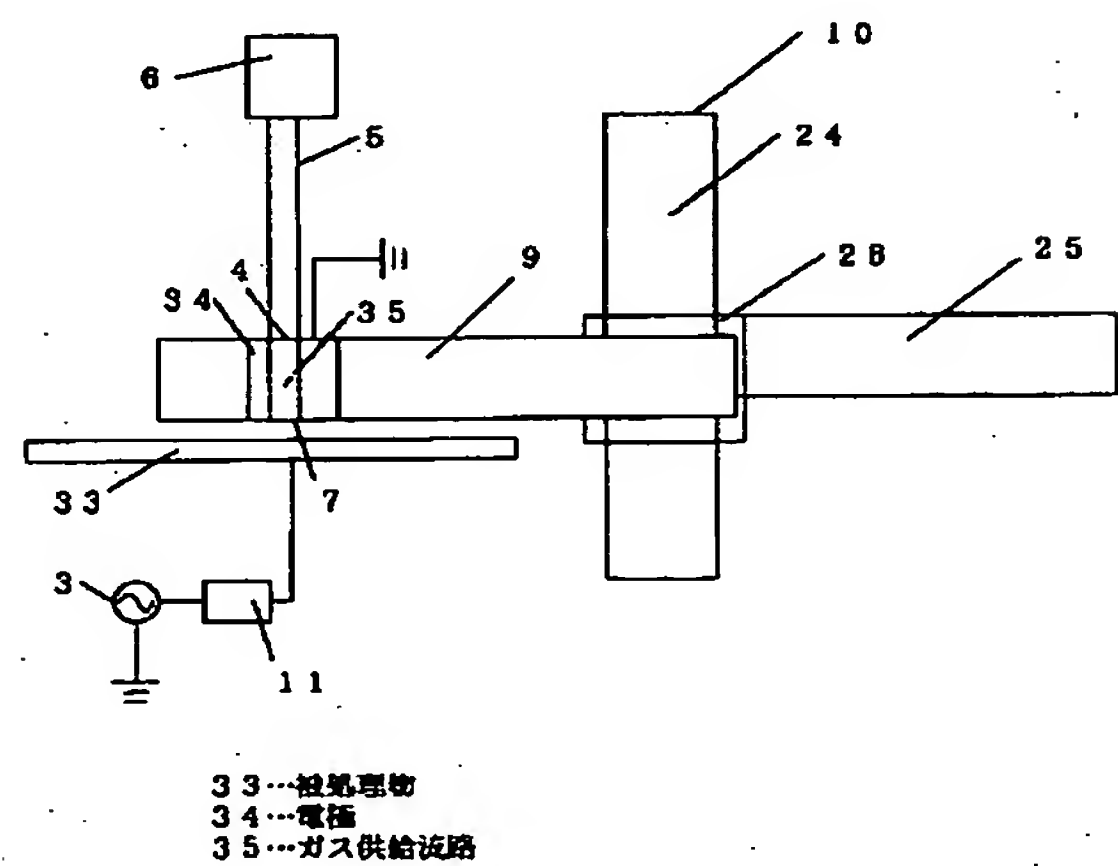
【図3】



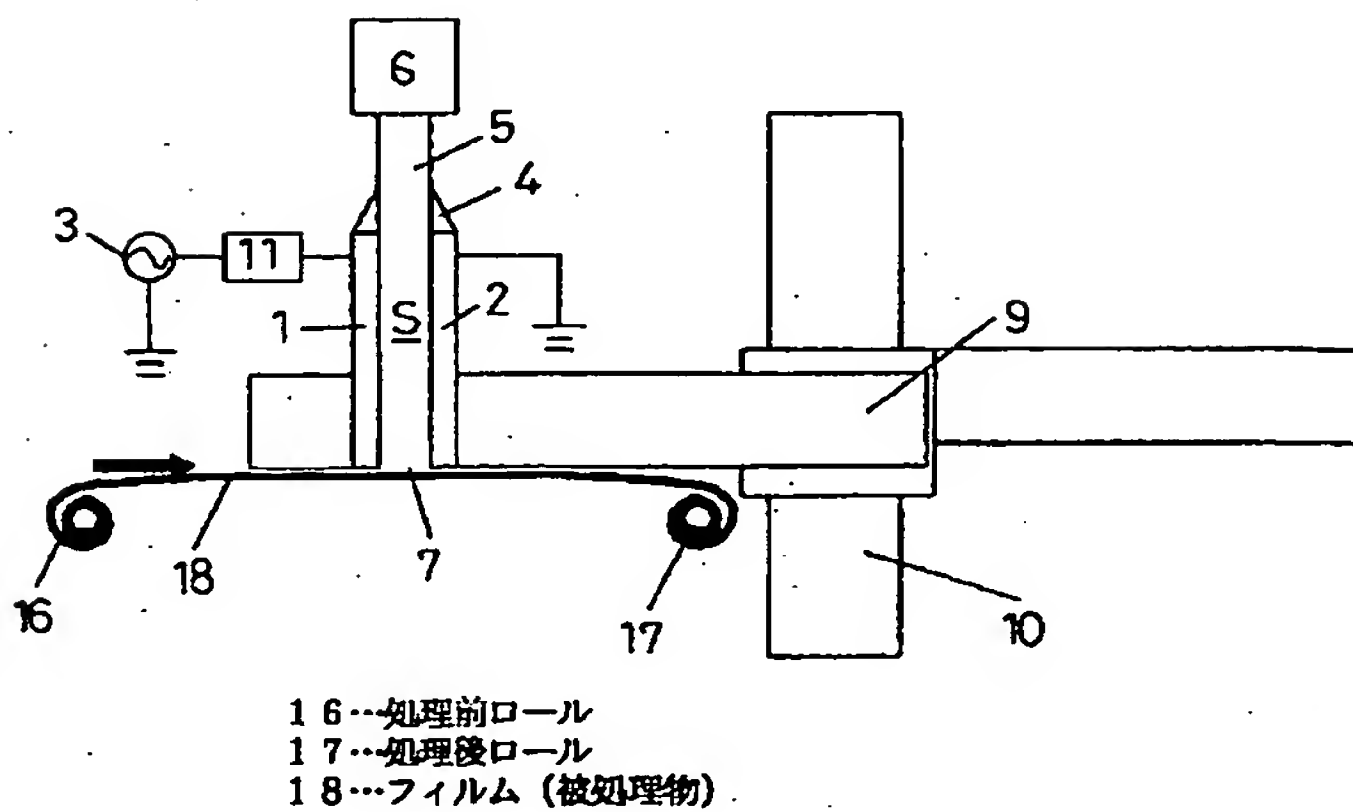
【図4】



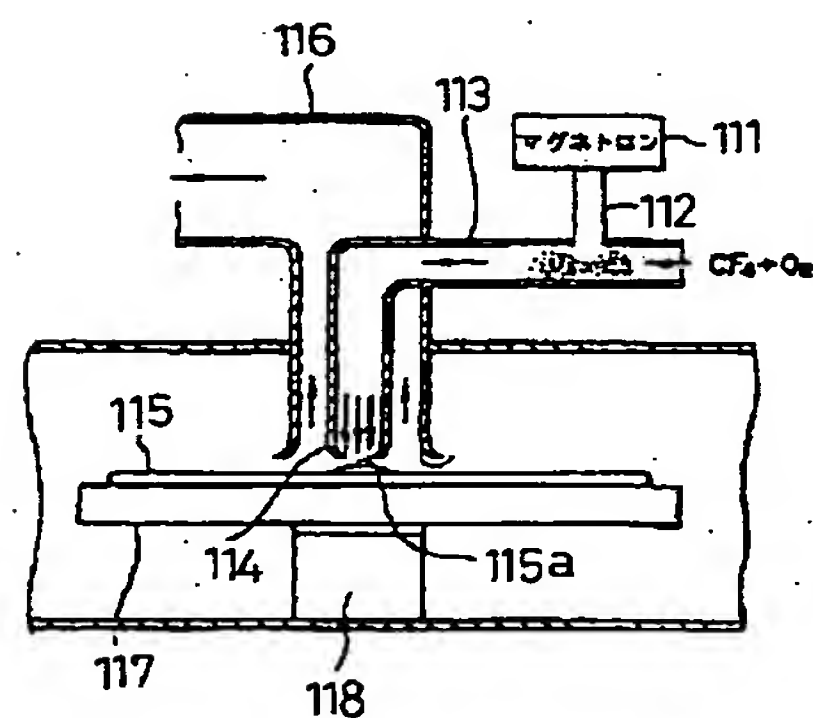
【図6】



【図5】



【図8】



フロントページの続き

(72)発明者 木村 忠司
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72)発明者 齋藤 光央
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

Fターム(参考) 4G075 AA29 AA30 AA62 BC01 BC06
CA15 CA25 CA62 CA63 DA02
DA12 DA18 EB42 ED04 ED13
4K030 CA17 FA01 GA04 GA14 JA01
JA09 JA18 LA11
5F004 BA20 BB11 BC06 BD03 BD04
CA02 DB23 EA38
5F045 AA08 AE19 AE21 AE23 AE25
BB08 DB09 DC70 EH13 EN04